GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN2003A

1、概述

GN2003A是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个NPN达林顿管组成。所有 单元共用发射极,每个单元采用开集电极输出。每一对达林顿都串联一个2.7 K的基极电阻,直接兼容TTL和5V CMOS电路,可以直接处理原先需要标准逻辑 缓冲器来处理的数据。GN2003A工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA ,并且能够在关态时承受80V的电压,输出还可以在高负载电流下并行运行, 很好的提供了需要多接口驱动电路的解决方案。

主要特点

- · 工作电压范围宽
- · 七路高增益达林顿阵列
- ·输出电压高(可达50V)
- ·输出电流大(可达 500mA)
- ·可与TTL、CMOS、PMOS直接连接
- · 内置钳位二极管适应感性负载

应用领域

- · 继电器驱动
- · 直流照明驱动
- · 步进电机驱动
- 电磁阀
- · 直流无刷电机驱动

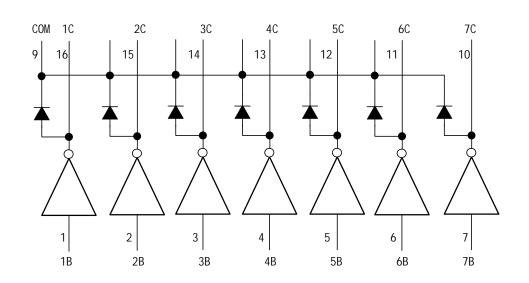
封装形式

GN2003A SOP16 4000PCS/盘 8000PCS/盒 64000PCS/箱

SOP-16

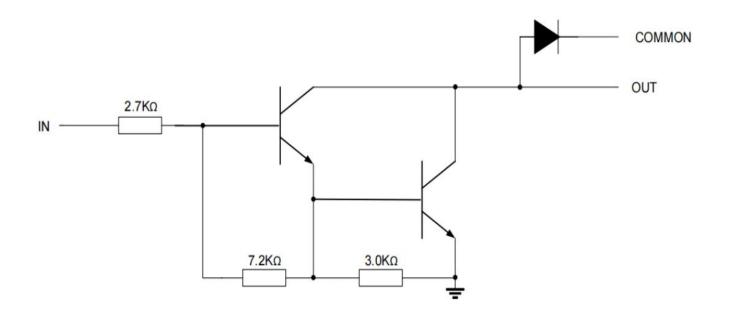
2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

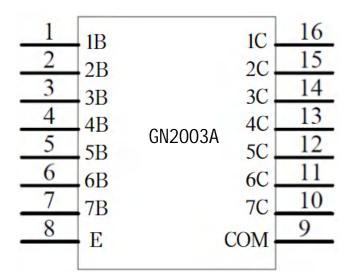




2.2、内部等效线路图



2.3、引脚说明



引脚	符号	功能	引脚	符号	功能
1	1B	输入1	9	СОМ	公共端
2	2B	输入 2	10	7C	输出 7
3	3B	输入3	11	6C	输出 6
4	4B	输入 4	12	5C	输出 5
5	5B	输入 5	13	4C	输出 4
6	6B	输入 6	14	3C	输出 3
7	7B	输入7	15	2C	输出 2
8	E	地	16	1C	输出 1



旌芯半导体科技(上海)有限公司

GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN2003A

3、电特性

3.1、极限参数

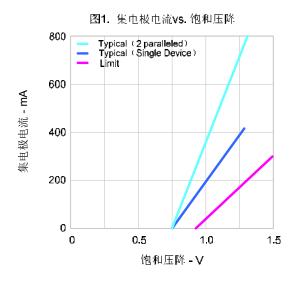
参数	符号	范 围	单位
输入电压	V_{IN}	-0.5~30	V
输出电压	V _{OUT}	-0.5~50	V
钳位二极管反向电压	V_{R}	80	V
集电极持续工作电流	l _{out}	500	mA
钳位二极管正向电流	IF	500	mA
储藏温度	T _{STG}	-55~150	°C
工作温度	T _{OPR}	-40~85	°C
结温	TJ	-40~150	°C

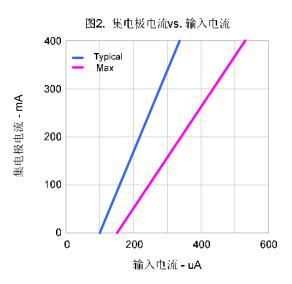
3.2、电气特性参数(除非特别指定 Ta=25)

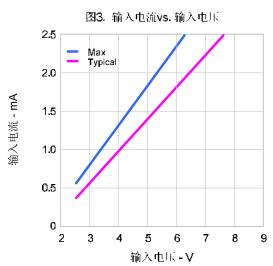
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位			
	I _{CEX}	T _A =25°C,V _{CE} =50V(图1)			20				
输出管漏电流		T _A =85°C,V _{CE} =50V(图1)		100		uA			
		I _{OUT} =350mA,I _{IN} =500 uA(图3)		1.3	1.6				
CE饱和压降	V _{CE} (sat)	I _{OUT} =250mA,I _{IN} =350 uA(图3)		1.1	1.3	V			
		I _{OUT} =100mA,I _{IN} =250 uA(图3)		0.9	1.1				
开态输入电流	I _{I(ON)}	V _I =3.85V(图4)		1.2	1.35	mA			
		I _C =500uA(图5)	50	100					
关态输入电流	I _{I(OFF)}	T _A =+25°C	50	100		uA			
		T _A =+85°C	25	50					
		V _{CE} =2.0V,I _C =200mA(图6)		2.4					
开态输入电压	$V_{I(ON)}$	V _{CE} =2.0V,I _C =250mA(图6)			2.7	V			
		V _{CE} =2.0V,I _C =300mA(图6)	3.0						
输入电容	Cı			15	30	pF			
导通延迟时间	t _{MH}	0.5V ₁ to 0.5 V ₀			1.0				
关断延迟时间	t _{ML}	0.5V ₁ to 0.5 V ₀			1.0	μS			
		V _R =50V(图7)							
嵌位二极管漏电流	I_R	T _A =+25°C		5	10	μΑ			
		T _A =+85°C		10	50	0			
嵌位二极管正向压降	V _F	I _F =350mA(图8)		1.7	2.0	V			

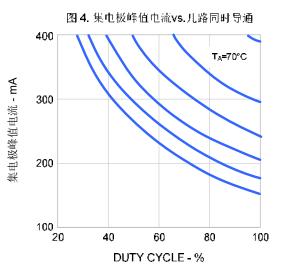
- 注:1、极限值是指超出该范围,器件有可能被损坏,并非器件的正常工作条件范围。电参数表提供了器件的工 作条件范围;
 - 2、除特别指明外,所有条件适用于达林顿阵列;
 - 3、通常条件下,每路输出在 70 、VCE (Sat)= 1.6V 下脉冲宽度为 20ms 的持续工作电流为 350mA。

4、典型特性曲线



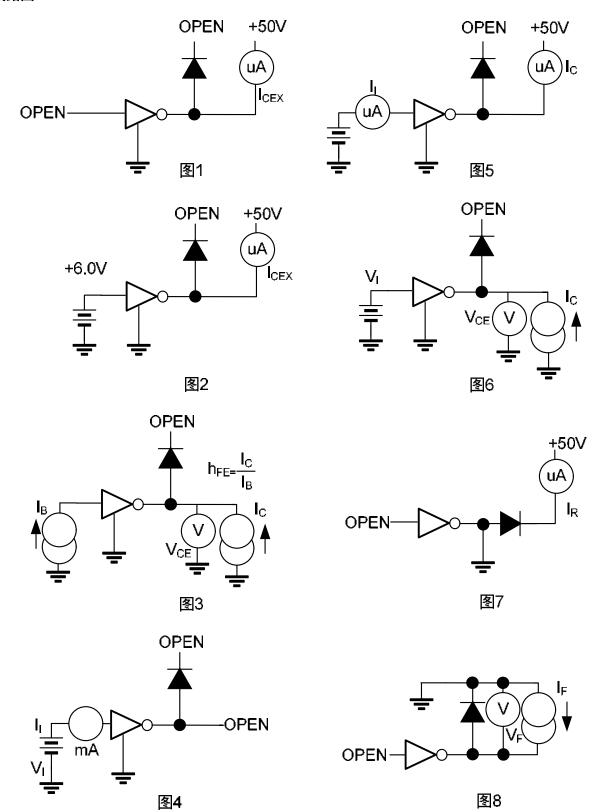








5、测试线路图

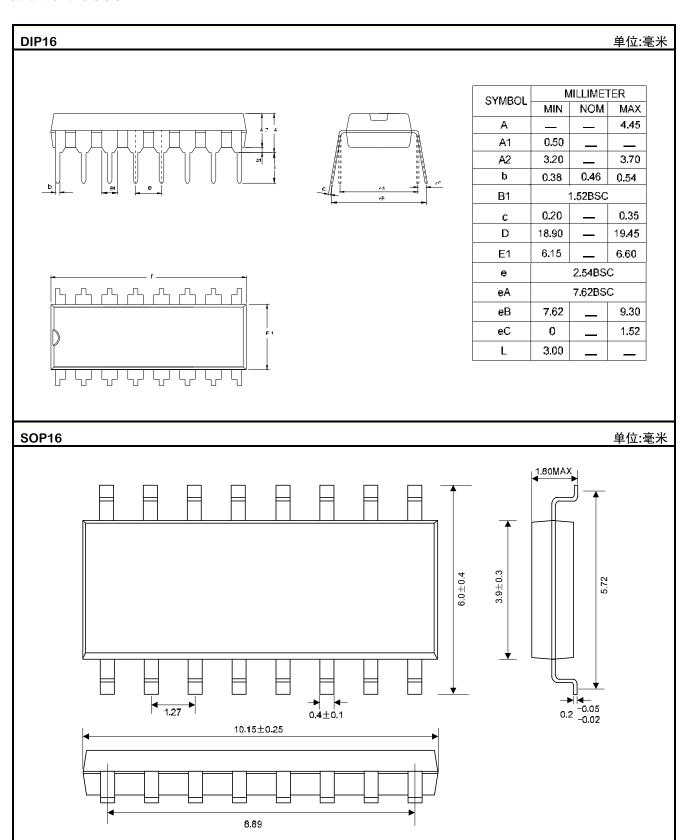




GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN2003A

6、封装尺寸与外形图





旌芯半导体科技(上海)有限公司

GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN2003A

7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素									
部件 名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六阶铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基巳 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
引线框	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塑封 树脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芯片	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内引线	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装片胶	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0
说明	○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考,本公司不作任何明示或暗示的保证,包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利 等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备,也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、 死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险,本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试,以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。 本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利,本资料中的信息如有变化,恕不另行通知,建 议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料,如果由本公司以外的来源提供,则本公司不对其内容负责。